

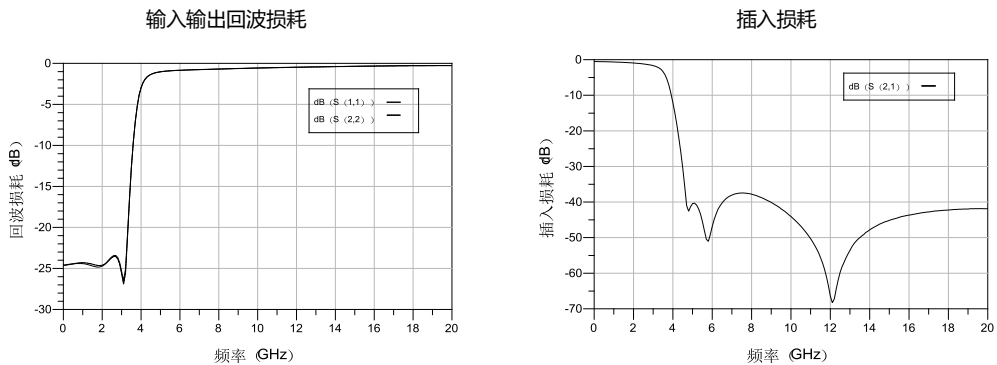
性能特点：

- 通带频率：DC-3GHz
- 通带损耗：≤1.7dB
- 阻带衰减：≥30dB@4.5GHz
- 回波损耗：≥23dB
- 芯片尺寸：1.0×0.70mm×0.1mm

产品简介：

HH-LF030 是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点，广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现，性能不受外部箱体影响，使用简单方便。芯片尺寸 1.0mmx0.70mm x 0.1mm。

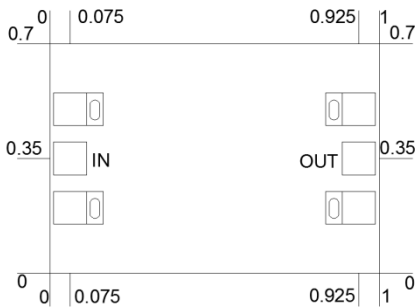
典型曲线： (TA=25°C)



使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

最大输入功率	33dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

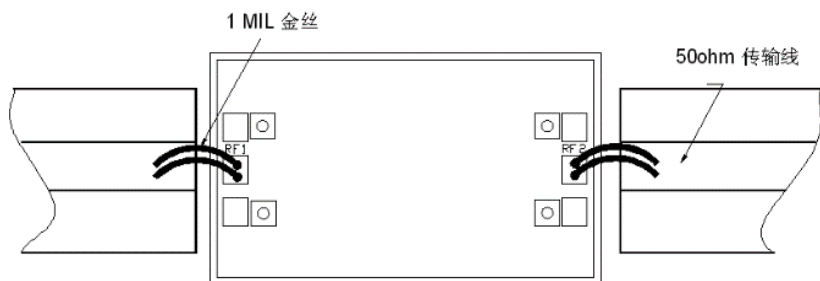
芯片实物尺寸图：(单位 mm)



说明：

5. 单位：毫米，公差：±0.05mm
6. 芯片背面镀金、接地
7. 键合压点镀金，压点尺寸：0.1mm*0.1mm
8. 不能在通孔上进行键合

芯片建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出用 2 根（直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。